(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(II)特許出願公開番号 特開平10-64119

(43)公開日 平成10年(1998) 3月6日

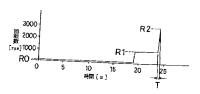
					,	43)公開日	平成10年	F(1998)3月6日
(51) Int.Cl. ^e G 1 1 B	7/24 7/26	識別記号 535	庁内整理番号 8721-5D 8940-5D	F I G11B	7/24 7/26	5	3 5 G	技術表示箇所

		審査請求 _	未請求 請求項の数3 OL (全 9 頁)
(21)出願番号	特顯平8-216253	(71)出顧人	
(22)出顧日	平成8年(1996)8月16日		シャープ株式会社 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号
		(72)発明者	田島 秀春
			大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ
			ヤープ株式会社内
		(74)代理人	弁理士 西教 圭一郎
		1	

(54) 【発明の名称】 光ディスクおよびその製造方法

(57)【要約】

【課題】 悪条件の環境下でも精度良く再生および記録 が行える光ディスクおよびその製造方法を提供する。 【解決手段】 光ディスクの保護膜を塗布する保護膜塗 布工程において、基板に粘度400~600cPの樹脂 を吐出し、基板を回転数R1=500~1500rpm で回転させる。時間T=0.1~0.5秒の間に、回転 数を回転数R2=4000~6000rpmに上げてす ぐに零に下げて保護膜を塗布する。この保護膜塗布工程 によると、膜厚30~50μ mの保護膜を塗布でき、温 **度上昇による光ディスクの反りを小さくすることができ** る。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 円盤状の基板の片面に、トラッキング用 の案内溝および記録膜が形成され、保護膜が塗布され、 光が照射されて信号が記録または再生される光ディスク において、

保護膜の膜厚W1が30μm≤膜厚W1≤50μmの範 囲にあることを特徴とする光ディスク。

【請求項2】 円盤状の基板の片面に、トラッキング用 の案内満を形成する工程と

前記基板上に記録膜を形成する工程と、

スピンコート法によって前記基板上に保護膜を塗布する 保護膜塗布工程とを含む光ディスクの製造方法におい

前記保護膜塗布工程において、基板上に粘度Cの樹脂を 吐出して、回転数R1で所定時間基板を回転させてか ら、回転数を回転数R1から回転数R1よりも大きい回 転数R2に上昇させた後、回転数を零に下降させて保護 膜を塗布することを特徴とする光ディスクの製造方法。 【請求項3】 前記保護膜塗布工程において、回転数が 回転数R1から上昇し始めるときから、回転数が回転数 20 R2を経由して零になるときまでの時間間隔を時間Tと

前記樹脂の粘度C、回転数R1、回転数R2および時間 Tは下記の関係式(1)~(4)を満たすことを特徴と する請求項2記載の光ディスクの製造方法。

- 400cP≤粘度C≤600cP
- (2) 500rpm≤回転数R1≤1500rpm
- (3) 2000rpm≤回転数R2≤4000rpm
- (4) 0.1秒≤時間T≤0.5秒

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、片面だけに信号が 記録される光ディスクおよびその製造方法に関する。 [0002]

【従来の技術】図15は光ディスク1の断面図である。 光ディスク1を構成する基板2は、ポリカーボネートか ら成る薄い円盤である。基板2の片面には、トラッキン グ用の案内溝3が形成され、その上には金属製の記録膜 4が形成され、さらにその上にはアクリル系ウレタン樹 脂から成る保護膜5が塗布されている。案内溝3の深さ 40 および記録膜4の膜厚は、共に0.1μm程度である。 光ディスク1の厚さW2は1.2mmであり、従来は保 護膜5の膜厚W1を10μm程度としている。

【0003】光ディスク1の製造方法において、スピン コート法によって保護膜5を塗布する保護膜塗布工程 は、以下のように行われる。基板2を微小な回転数R0 で回転させて基板2上に樹脂を吐出する。樹脂を吐出し た後、基板2を回転数R2で所定時間回転させてから、 回転数を零に下降させて保護膜5を途布する。

工程の一例を示すグラフである。グラフの横軸は時間 (単位は秒)であり、縦軸は回転数(単位はrpm)で ある。図16の例に従って保護膜塗布工程を行うと、基 板2に粘度100~200cPまたは400~600c Pの樹脂を1g程度吐出して、回転数R2=3000r pmで回転させて保護膜5を塗布する。こうして膜厚W 1=10μmの保護膜5を塗布している。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】 光ディスク1は室温よ 10 りも高温の環境の下で、たとえば55℃で反りを生じる 傾向がある。通常、光ディスク再生装置あるいは記録装 置は、光ディスク1を長時間にわたって連続使用すると 約55℃まで温度が上昇するので、光ディスク1に反り を生じさせることがある。このように反りを生じた光デ ィスク1を使って再生および記録すると、特に光ディス ク1の反りが激しい部分では、トラッキングエラーやフ ォーカシングエラーが生じて、再生や記録が不可能にな る。

【0006】図17は光ディスク1の反りを示す図であ る。光ディスク1は、基板2の案内溝3を有する保護膜 5を内側に向けた円弧を描くように反っている。光ディ スク1は異なる複数の材料から成っているので、場所に よって熱脳張の度合に偏りがある。基板2はポリカーボ ネート製であり、光ディスク1を構成する他の材料より も熱膨張し易い。一方、光ディスク1の保護膜5側に は、熱膨張の少ない案内溝3がある。この案内溝3があ るので、光ディスク1は図17に示すような反りを生じ 8.

【0007】光ディスク1の反りは保護膜5の膜厚W1 30 が薄いほど大きく、従来の光ディスク1のように保護膜 5の膜厚W1が10μm程度のものでも反ることがあ る。光ディスク1の反りを小さくするためには、保護膜 5の膜厚W1を厚くする必要がある。保護膜5の膜厚W 1を厚くすることは、樹脂の吐出量を増やすことで可能 であるが、以下に示すように従来の保護膜塗布工程では 限界がある。

【0008】図18は樹脂の吐出量に対する保護膜5の 膜厚W1を示すグラフである。グラフの横軸は樹脂の叶 出量(単位はg)であり、縦軸は保護膜5の膜厚W1

(単位はμm)である。樹脂の吐出量を様々に変えて保 護膜塗布工程を行い、その結果を図18に示した。図1 8によると、吐出量が増加するに従って膜厚W1は厚く なり、膜厚W1はしだいに約15 gmに近づくが、15 μmを越えることはない。従来の保護膜塗布工程では、 厚い保護膜を塗布することは困難である。

【0009】本発明の目的は、悪条件の環境下でも精度 良く記録または再生できる光ディスクおよびその製造方 法を提供することである。

[0010]

【0004】図16は従来の光ディスク1の保護膜塗布 50 【課題を解決するための手段】本発明は、円盤状の基板

の片面に、トラッキング用の案内溝および記録膜が形成 され、保護膜が塗布され、光が照射されて信号が記録ま たは再生される光ディスクにおいて、保護膜の膜厚W1 が30µm≤膜厚W1≤50µmの範囲にあることを特 徴とする光ディスクである。

本発明に従えば、従来よりも厚い保護膜を塗布すること で、温度上昇による光ディスクの反りは小さくなり、光 ディスクは精度良く記録または再生できるようになる。 なお本発明の光ディスクは、再生専用のCD (コンパク トディスク)、1回だけ書き込み可能なCD-R、およ 10 び光磁気効果によって何度でも書き換え可能な光磁気デ ィスクを含む概念である。

【0011】また本発明は、円盤状の基板の片面に、ト ラッキング用の案内溝を形成する工程と、前記基板上に 記録膜を形成する工程と、スピンコート法によって前記 基板上に保護膜を塗布する保護膜塗布工程とを含む光デ ィスクの製造方法において、前記保護膜塗布工程におい て、基板上に粘度Cの樹脂を吐出して、回転数R1で所 定時間基板を回転させてから、回転数を回転数R1から 転数を零に下降させて保護膜を塗布することを特徴とす る光ディスクの製造方法である。

本発明に従えば、光ディスクの保護膜塗布工程におい て、基板が回転数R1で回転する遂心力によって樹脂を 基板上に広げることができる。また基板が第1回転数R 1よりも大きい回転数R2で回転すると、さらに大きな 遠心力によって、基板の外周部分に広がった樹脂を振り 切ることができる。また従来の保護膜塗布工程では回転 数R2だけで基板を回転させていたのに対し、本発明の 保護膜塗布工程では回転数R2で回転させる前に、回転 30 数R2よりも小さい回転数R1で回転させることによっ て、従来よりも厚い保護膜を塗布できる。

【0012】また本発明の保護膜塗布工程において、回 転数が回転数R1から上昇し始めるときから、回転数が 回転数R2を経由して零になるときまでの時間間隔を時 間Tとし、前記樹脂の粘度C、回転数R1、回転数R2 および時間下は下記の関係式(1)~(4)を満たすこ とを特徴とする。

- 400cP≦粘度C≤600cP
- (2) 500rpm≤回転数R1≤1500rpm
- (3) 2000rpm≤回転数R2≤4000rpm
- (4) 0.1秒≤時間T≤0.5秒

本発明に従えば、光ディスクの保護膜塗布工程におい て、各パラメータは上記の関係式(1)~(4)を満た し、従来よりも厚い保護膜を塗布することができる。 [0013]

【発明の実施の形態】本発明の一実施形態の光ディスク 1の構成は、保護膜5の膜厚W1が異なる以外は従来技 術の光ディスクと同様であり、図15に図示している。 【0014】図1は光ディスク1の反り角(図2参照) 50 【0020】記録膜4を有する側の面を上に向けた基板

4 が保護膜5の膜厚W1に依存する様子を示すグラフであ る。このグラフの横軸は時間(単位は分)であり、縦軸 は光ディスク1の反り角(単位はmrad)である。保護膜 5の膜厚W1を様々に変えて、光ディスク1を温度55 ℃、湿度30%の環境下に放置する実験を行い、その結 果として光ディスク1の反りの変化を図1に示した。膜 厚W1として10、15、20、30、50μmの各値 を選び、放置時間に対して光ディスク1の反り角を10 分毎にプロットしか.

【0015】図2は光ディスク1の反り角を示す図であ る。光ディスク1が、その上面を内側に向けた円弧を描 くように反ったとき、光ディスク1の軸線しが光ディス ク1を貫く位置における光ディスク1の接平面を基準面 Aとする。光ディスク1上のある点Pの反り角 θ は、点 Pにおける光ディスク1の接平面Bと基準面Aとのなす 角のことである。光ディスク1の反り角は、光ディスク 1上の任意の点における反り角のうちの最大値である。 【0016】図1に示されるように、放置時間が20分 を越える部分では、光ディスク1を構成する保護膜5の 回転数R1よりも大きい回転数R2に上昇させた後、回 20 膜厚W1が薄いほど、光ディスク1の反り角は大きくな っている。膜厚W1=10、15、20μmの光ディス ク1については、放置時間が30分以降の部分で反り角 が4.5mradを越えてさらに大きくなって行く、これに 対して膜厚W1=30、 $50\mu m$ の光ディスク1につい

> 【0017】上述のように、保護膜5の膜厚W1を30 ~50µmとする光ディスク1では、温度上昇に起因す る反りが非常に小さいことがわかる。また膜厚W1=1 O、15、20µmの光ディスク1では、温度55℃で 反り角が4.5mradを越えて、光ディスクの規格などか ら外れてしまう。よって保護膜5の膜厚W1を30~5 Oμmとして構成した光ディスク1は、温度上昇による 反りを生じ難い。

ては、ほぼ横遣い状態である。

【0018】図3は光ディスク1の一般的な製造方法を 示す図である。ガラス原盤11にフォトレジスト12を 塗布し、所定のパターンどおりにレーザ光線を照射す る。レーザ露光されたフォトレジスト12は、現像処理 されて、レーザ光線が照射されたパターンに対応したパ ターンを呈する。この上にニッケル膜13を形成してフ 40 オトレジスト12およびガラス原盤11を除去すると、 ニッケル膜13は、フォトレジスト12と凹凸の反転し たパターンを有するスタンパ14になる。

【0019】このスタンバ14を用いてもとのレーザ露 光されたフォトレジスト12のパターンを以下のように 複製する。スタンパ14を用いてポリカーボネートを射 出成形して、レプリカの基板2を形成する。この上に金 属製の薄い記録膜4を蒸着して形成し、さらにこの上に 保護膜5を塗布する。保護膜5を塗布する保護膜塗布工 程は、以下のようなスピンコート法によって行われる。

2を、微小な回転数ROで回転させながら、基板2 Fの 回転軸付近に粘度Cのアクリル系ウレタン樹脂を吐出す る。樹脂を吐出した後、回転数を回転数ROから所定の 回転数R1に瞬時に上昇させ、回転の遠心力で樹脂を基 板2上に広げる。樹脂が拡がれば、瞬時のうちに回転数 をさらに回転数R2まで上昇させて、さらに大きな遠心 力で余分な樹脂を振り切る。回転数R2に到達すれば瞬 時に回転数を零まで下降させる。このとき回転数が回転 数R1から上昇し始めるときから、回転数が回転数R2 を経由して零に到達するときまでの時間を時間Tとす 10 【0025】 る。回転数R0は、回転数R1および回転数R2に比べ ると、無視できるほどの微小量であり、樹脂を広げた り、振り切ることには無関係である。

【0021】図4は光ディスク1の保護膜塗布工程の一 例を示すグラフである。このグラフの横軸は時間 (単位 は秒)であり、縦軸は基板2を回転させる回転数(単位 はrpm)である。図4に従って保護膜塗布工程を行う には、微小な回転数で基板2を回転させながら樹脂を基 板2に吐出し、回転数を1000rpmに上げて樹脂を 広げ、さらに0.5秒の間に回転数を3000rpmま 20 で上げてすぐに回転数を零に下げる。

【0022】図5~13は樹脂の膜厚W1と回転数R1 との関係を示すグラフである。グラフの横軸は基板2の 中心からの距離(単位はmm)であり、縦軸は保護膜5 の膜厚W1 (単位は μm) である。直径 90 mmのポリ カーボネート製の基板2に対して、各パラメータを様々 な値に変えて保護膜塗布工程を行い、その結果を図5~ 13に示した。ただし基板2に吐出する樹脂の粘度Cに ついては、温度25℃の下で400≤粘度C≤600c Pとし、回転数R1=300rpm、1000rpm、 5000rpmとし、回転数R2=1500rpm、3 000rpm、5000rpmとし、時間T=0.05 秒、0.3秒、0.8秒とした。

【0023】同じ保護膜塗布工程で、さらに回転数R1 =500rpm、1500rpm、回転数R2=200 0rpm、4000rpmおよび時間T=0.1秒、 0.5秒の条件を加えて、その結果を以下の表1~5に 示した。○は膜厚W1=30~50μmの均一な保護膜 5が塗布された条件を示し、×は均一な保護膜5が塗布 できなかった条件を示している。

[0024] 【表1】

時間T=0.05秒

R2\R1	300	500	1000	1500	5000
1500	X	X	×	X	70¢0
2000	×	×	×	- X	
3000	^	×	-^-		×
4000				X	×
	×	X	×	×	×
5000	X	×	×	×	×

【表2】

時間T=0.1秒

R2\R1	300	500	1000	1500	5000
1500	×	×	×	×	×
2000	×	0	0	0	×
3000	×	0	0	0	×
4000	×	0	0	0	×
5000	×	×	Х	Х	×

[0026]

【表3】

時間T=0.3秒

R2∖R1	300	500	1000	1500	5000
1500	×	×	×	×	×
2000	×	0	0	0	×
3000	×	0	0	0	×
4000	×	0	0	0	×
5000	×	×	×	×	×

[0027]

【表4】

時間T=0.5秒

R2\R1	300	500	1000	1500	5000
1500	×	×	×	×	×
2000	×	0	0	0	×
3000	×	0	0	0	×
4000	×	0	0	0	×
5000	×	×	×	×	×

[0028] 【表5】

R2∕R1	300	500	1000	1500	5000
1500	×	×	Х	×	×
2000	×	х	×	×	×
3000	×	×	×	×	×
4000	×	×	×	×	×
5000	×	×	×	Х	Х

くなるほど膜厚が大きくなっていて、樹脂は基板2の端 部に盛り上がり、さらに基板2の裏面に回り込んでいる (図14参照)。折れ線22は半径方向距離に関わらず 膜厚40μmほどである。折れ線23は半径方向距離が 大きくなるほど膜厚が小さくなっていて、基板2上の外 周部分の膜厚が内周部分の膜厚よりも薄くなっている。 【0030】したがって回転数R2=1500rpm、 時間T=0.3秒の条件のもとでは、回転数R1=10 ○ ○ r p m のとき膜厚3 0 ~ 5 0 µ m の均一な保護膜が 膜厚W1=30~50μmの均一な保護膜は塗布されな かった。 図5~8 および図10~13 についても同様な ので詳しい説明を省略するが、このいずれの場合も膜厚 30~50 µmの均一な保護膜は塗布されなかった。 【0031】表1(時間T=0.05秒)および表5 (時間T=0.8秒)に示されるように、回転数R1、 R2がいずれのときも膜厚W1=30~50µmの均一 な保護膜は塗布されなかった。表2(時間T=0.1 秒)、表3(時間T=0.3秒)および表4(時間T= O. 5秒) に示されるように、回転数R1=500、1 30 000、1500rpmかつ回転数R2=2000、3 000、4000rpmのときに、膜厚W1=30~5 0 μmの保護膜が塗布された。

【0032】まとめると、時間Tが0.1秒よりも小さ いときは、樹脂の振り切りが足りずに基板2の端部に盛 り上がったまま残った。また時間Tが0.5秒よりも大 きいときは、樹脂が振り切られ過ぎて外周部分の膜厚が 薄くなった。回転数R1が500rpmよりも小さいと きは、樹脂の振り切りが足りずに基板2の端部に盛り上 がったまま残った。また回転数R1が1500rpmよ 40 りも大きいときは、膜厚が30μmよりも小さくなっ た。回転数R2が2000rpmよりも小さいときは、 樹脂の振り切りが足りずに基板2の端部に盛り上がった まま残った。また回転数R2が4000rpmよりも大 きいときは、樹脂が振り切られ過ぎて外周部分の膜厚が 薄くなった。

【0033】樹脂の粘度Cについては、他の粘度の樹脂 を使うことも可能であるが、粘度Cが400cPよりも 小さいか、または600cPよりも大きいときには、膜 厚W1=30~50μmの均一な保護膜を塗布できな 50 【図9】回転数R2=3000rpm、時間T=0.3

い。たとえば100cP≦粘度C≦200cPの樹脂を 用いると、膜厚が30µmよりも薄くなってしまう。 【0034】上述のように保護膜塗布工程において、各 パラメータが請求項3の関係式(1)~(4)を満たす と、膜厚W1=30~50 µmの均一な保護膜5を塗布 できる。しかもこうして形成した光ディスク1は温度上 昇による反りが少ない。

【0035】なお本発明の光ディスク1は厚さW2=

1. 2mmのものであり、記録膜4が片面だけに形成さ 【0029】図9の折れ線21は、半径方向距離が大き 10 れていれば良い。たとえば、再生専用のCDやCD-ROMのように、トラッキングおよび信号再生のためのピ ットが案内溝3であり、光の反射率を上げるためのアル ミニウム薄膜が記録膜4であるものでも良い。また、再 生および記録が可能なMOなどの光磁気ディスクのよう に、トラッキング用のグルーブが案内溝3であり、信号 を再生および記録するための磁性膜が記録膜4であるも のでもよい。

[0036]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、温度上昇 塗布され、回転数R1=300、5000rpmのとき 20 による光ディスクの反りを少なくすることによって、光 ディスクの再生および記録を、より精度良く行える。 【0037】また本発明によれば、光ディスクの保護膜 塗布工程において、基板を回転数R2で回転させる前 に、それよりも小さい回転数R2で回転させることによ って、従来よりも厚い保護膜を塗布できる。 【0038】また本発明によれば、関係式(1)~ (4)を満たす各パラメータを用いて、光ディスクの保 護膜塗布工程を行うと、さらに厚い保護膜を塗布でき

【図面の簡単な説明】

【図1】光ディスク1の反り角と保護膜5の膜厚W1と の関係を示すグラフである。

【図2】光ディスク1の反り角を示す断面図である。

【図3】光ディスク1の一般的な製造方法を示す図であ

【図4】光ディスク1の保護膜途布工程における回転数 と時間との関係の一例を示すグラフである。

【図5】回転数R2=1500rpm、時間T=0.0 5秒のときに、保護膜5の膜厚W1と回転数R1との関 係を示すグラフである。

【図6】回転数R2=3000rpm、時間T=0.0 5秒のときに、保護膜5の膜厚W1と回転数R1との関 係を示すグラフである。

【図7】回転数R2=5000rpm、時間T=0.0 5秒のときに、保護膜5の膜厚W1と回転数R1との関 係を示すグラフである。

【図8】回転数R2=1500rpm、時間T=0.3 秒のときに、保護膜5の膜厚W1と回転数R1との関係 を示すグラフである。

9

秒のときに、保護膜5の膜厚W1と回転数R1との関係 を示すグラフである。

【図10】回転数R2=5000rpm、時間T=0. 3秒のときに、保護膜5の膜厚W1と回転数R1との関 係を示すグラフである。

【図11】回転数R2=1500rpm、時間T=0. 8秒のときに、保護膜5の膜厚W1と回転数R1との関 係を示すグラフである。

【図12】回転数R2=3000rpm、時間T=0. 8秒のときに、保護膜5の膜厚W1と回転数R1との関 10 係を示すグラフである。

【図13】回転数R2=5000rpm、時間T=0. 8秒のときに、保護膜5の膜厚W1と回転数R1との関 係を示すグラフである。

【図14】樹脂が基板2の裏面に回り込んで塗布された 保護膜5を示す断面図である。

【図15】光ディスク1の断面図である。

【図16】従来の光ディスク1の保護膜塗布工程におけ る回転数と時間との関係の一例を示すグラフである。

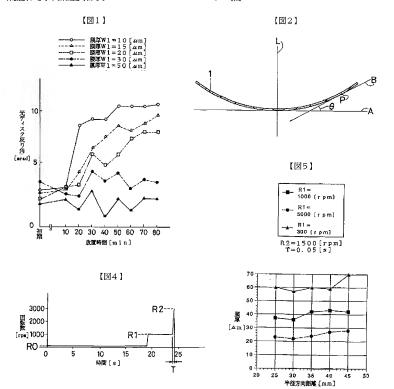
10

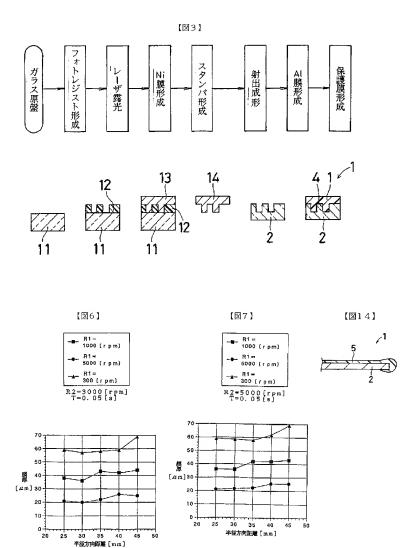
【図17】光ディスク1の反りを示す断面図である。

【図18】樹脂の吐出量に対する保護膜5の膜厚W1を 示すグラフである。

【符号の説明】

- 1 光ディスク
- 2. 基板
- 3 案内溝
- 4 記録膜
- 5 保護膜
- W1 膜厚
- C 粘度
- R1, R2 回転数
- 丁 時間





.

